








	<h2>SPB80N03S2L-04 G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB80N03S2L-04 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB80N03S2L-04 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPB80N03S2L-04 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 130µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPB80N03S2L-04 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N03S2L-04 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N03S2L-04 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB80N03S2L-04 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB80N03S2L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N03S2L-05 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N03S2L-03 / 2N03L03 INF SPB80N03S2L-03 / 2N03L03 INF</p>	 <p>SPB80N03S2L-03 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p>SPB80N03S2L-06 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N03S2L-06G INFINEO SPB80N03S2L-06G INFINEO</p>	 <p>SPB80N03S2L-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N03S2L-06 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB80N03S2L-04 G International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB80N03S2L-04 G Datenblatt	SPB80N03S2L-04 G-Datenblätter	SPB80N03S2L-04 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N03S2L-04 G
SPB80N03S2L-04 G Electronic	SPB80N03S2L-04 G-Komponenten	SPB80N03S2L-04 G-Verteiler	SPB80N03S2L-04 G-Bild	SPB80N03S2L-04 G-Teil
SPB80N03S2L-04 G Preis	SPB80N03S2L-04 G Hersteller	SPB80N03S2L-04 G Bild	SPB80N03S2L-04 G Aktie	SPB80N03S2L-04 G Inventar
SPB80N03S2L-04 G Neu	SPB80N03S2L-04 G Original	SPB80N03S2L-04 G garantiert	SPB80N03S2L-04 G RFQ	SPB80N03S2L-04 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited